



原寸大

小型SOJ高周波水晶発振器

SG-636シリーズ

- C-MOS IC使用による低消費電力
- 小型SMDパッケージにより、高密度実装が可能
- 耐熱型シリンドラAT水晶振動子内蔵で一般SMD ICと同等のハンダ付け方法が可能
- アウトプットイネーブル機能、スタンバイ機能付き

■仕様 (特性)

項目	記号	仕様				条件	
		SG-636PTF	SG-636PTJ	SG-636PH	SG-636SCE/PCE		
出力周波数範囲	f_0	2.21675MHz ~41.0000MHz	41.0001MHz~70.0000MHz	2.21675MHz ~41.0000MHz			
電源電圧	最大供給電圧	V_{DD-GND}	-0.3V~+7.0V	-0.5V~+7.0V			
	動作電圧	V_{DD}	5.0V±0.5V	3.3V±0.3V			
温度範囲	保存温度	T_{STG}	-55°C~+100°C				
	動作温度	T_{OPR}	-20°C~+70°C				
ハンダ付け条件	T_{SOL}	260°C以下×10秒以内×2回					
周波数安定度	$\Delta f/f_0$	C: ±100ppm					
消費電流	I_{op}	17mA max.	35mA max.		9mA max.	無負荷	
ディセーブル時電流	I_{OE}	10mA max.	28mA max.	20mA max.	5mA max.	OE=GND ST=GND, 2μA max. (SCE)	
デューティ	t_w/t	40%~60%		—	40%~60%	45%~55%	C-MOS負荷: 1/2 V_{DD} レベル
		45%~55%		—			TTL負荷: 1.4Vレベル
“H”レベル出力電圧	V_{OH}	$V_{DD}-0.4V$ min.	2.4V min.	$V_{DD}-0.4V$ min.		$I_{OH}=-8mA(PTF)/-400\mu A(PTJ)/-4mA(PH/SCE/PCE)$	
“L”レベル出力電圧	V_{OL}	0.4V max.				$I_{OL}=16mA(PTF)/8mA(PTJ)/4mA(PH/SCE/PCE)$	
出力負荷条件 (TTL)	N	10TTL max.	5TTL max.	5LSTTL max.	—	$C_L \leq 15PF$	
出力負荷条件 (C-MOS)	C_L	50pF max.	15pF max.	20pF max. ($\leq 55MHz$) 15pF max. ($> 55MHz$)	30pF max.		
“H”レベル入力電圧	V_{IH}	2.0V min.	3.5V min.	2.0V min.	0.8 V_{DD} min.	OE端子, ST端子 (SCE)	
“L”レベル入力電圧	V_{IL}	0.8V max.	1.5V max.	0.8V max.	0.2 V_{DD} max.		
出力上昇時間	t_{rLH}	7 ns max.	—	5 ns max.	—	C-MOS負荷: 20%→80% V_{DD} レベル	
		5 ns max.		—		TTL負荷: 0.4V→2.4Vレベル	
出力下降時間	t_{rHL}	7 ns max.	—	5 ns max.	—	C-MOS負荷: 80%→20% V_{DD} レベル	
		5 ns max.		—		TTL負荷: 2.4V→0.4Vレベル	
発振開始時間	t_{OSC}	4ms max.	10ms max.		4ms max.	最低動作電圧時を0とする	
経時変化	f_a	±5 ppm/年 max.				$T_a=25^\circ C$, 初年度	
耐衝撃性	S.R.	±20ppm max.				硬木上75cm×3回または3000G ×0.3ms. ×1/2 Sine Wave×3方向	

モールド部より内蔵の金属ケースの一部が見える場合があります。

■外形寸法図

(単位: mm)

■推奨ハンダ付けパターン図

(単位: mm)

